

四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式：FZ-T-12000-X-VIII-VPM-MII-PC



Crystal Systems Corp.

株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL 0551-36-5271 FAX 0551-36-5273

<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: csc@crystalsys.co.jp

1. 装置仕様書

型式	FZ-T-12000-X-VIII-VPM-MII-PC			
使用ランプ種類	キセノン			
使用ランプ、ミラー個数	4 (個)			
最高到達圧力	0.95 (MPa)			
最高到達真空度	5×10^{-5} (Torr) (6.7×10^{-3} Pa)			
シャフト部シール方式	磁性流体シール+高圧ベローズ			
最高到達温度	3,000 (°C)			
常用使用温度	2,800 (°C)			
標準具備ランプ (ランプは4本一組)	3,000 (W)			
円周方向温度差	50 (°C以下)			
ランプ冷却方式	空冷			
ミラー冷却方式	空冷			
石英管シール冷却方式	水冷			
シャフト/ミラーステージ	上下シャフト移動 / ミラーステージ固定			
下シャフト移動長(結晶育成長)	最大移動長 350 (mm) 結晶育成長 150 (mm)			
上シャフト移動長(原料棒供給長)	350 (mm)			
最大原料棒長	150 (mm)			
下シャフト(結晶育成)速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)			
下シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)			
上シャフト移動速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)			
上シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)			
上下シャフト回転速度	5~100 (rpm)			
熔融域観察方式	CMOS カメラ			
雰囲気ガス流量制御	マスフローコントローラー : ①Ar 5 (L/min) ②O ₂ 500 (cc/min) フロート式フローメーター : ③Air 10 (L/min) (Compressor 付)			
ランプ出力制御方式	プログラム式出力調整 (4本を一括制御)			
出力安定度	入力変動±10 (%)に対して±0.4 (%)以下			
用力	電力	三相 200 (V), 100 (A)		
	冷却水	5 (L/min)		
装置寸法 (mm)		本体	制御盤(ガスBOX含む)	キセノン電源
	幅	1,060	605	800
	奥行	800	760	700
	高さ	3,000	1,640	1,800

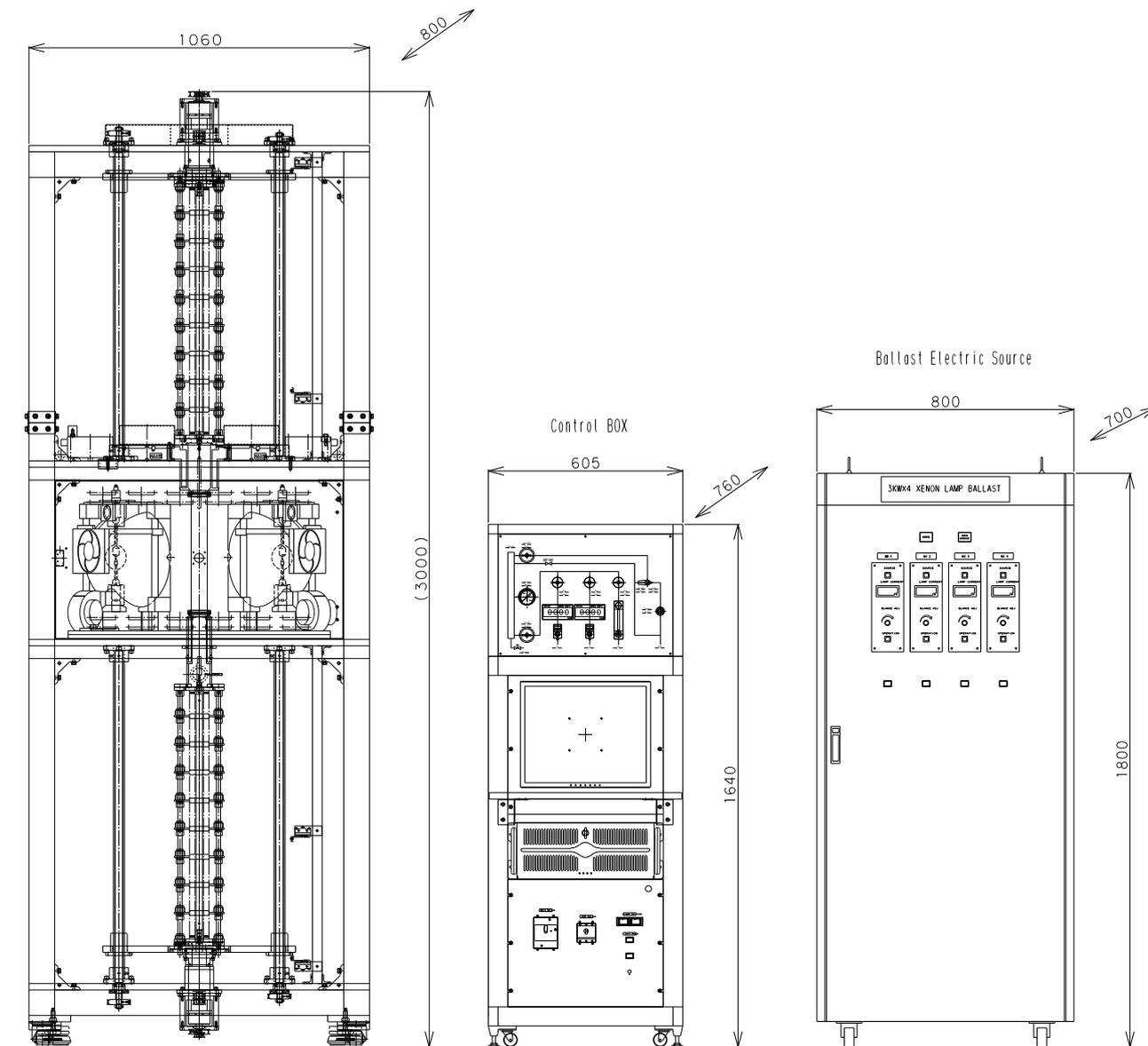
注) 上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。

2. 標準付属品

- 1) キセノンランプ 最高出力 3,000 (W) 8 (本)
- 2) 石英管 (標準管) 2 (本)
(高圧管) 2 (本)
- 3) O リング、バックアップリング (石英管シール) 4 (個)
(シャフトシール) 4 (個)
- 4) 種子結晶保持治具 2 (個)
- 5) 原料棒保持治具 2 (個)
- 6) 工具箱 1 (箱)

3. 参考図

FZ Furnace
FZ-T-12000-X-VIII-VPM-MII-PC



Unit:mm

4. 配置图

